性能特点：

- RF/LO 频段：13GHz～28GHz
- IF 频段：DC～10GHz
- 变频损耗：8dB
- RF-IF 隔离度：12dB
- LO-IF 隔离度：30dB
- LO-RF 隔离度：35dB
- 本振功率：13dBm
- 芯片尺寸：1.00mm×1.20mm×0.10mm

产品简介：

NC1733C-1328/NC1733C-1328 M 是一种 GaAs MMIC 无源双平衡混频器，芯片射频/本振频率覆盖 13GHz～28GHz，中频频率覆盖 DC～10GHz，变频损耗小于 10dB，射频到中频隔离度大于 8dB，本振到中频隔离度大于 15dB，本振到射频隔离度大于 25dB，典型本振输入功率 13dBm。芯片采用 GaAs 肖特基二极管工艺制造。

电参数：（T_A=+25℃，IF=0.1GHz，LO=+13dBm）

指标	最小值	典型值	最大值	单位
射频频率	13～28			GHz
本振频率	13～28			GHz
中频频率	DC～10			GHz
变频损耗	7.5	8	10	dB
LO-RF 隔离度	25	35	50	dB
LO-IF 隔离度	15	30	42	dB
RF-IF 隔离度	8	12	24	dB
射频输入 1dB 压缩点	9	10	13	dBm

注：除特殊标注，以上参数均为下变频模式测得，中频频率 0.1GHz，本振功率+13dBm。

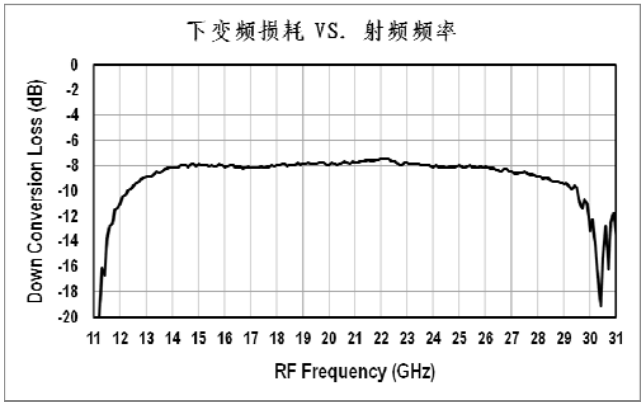
注：对于兴趣频点的交调指标可以与我公司联系。

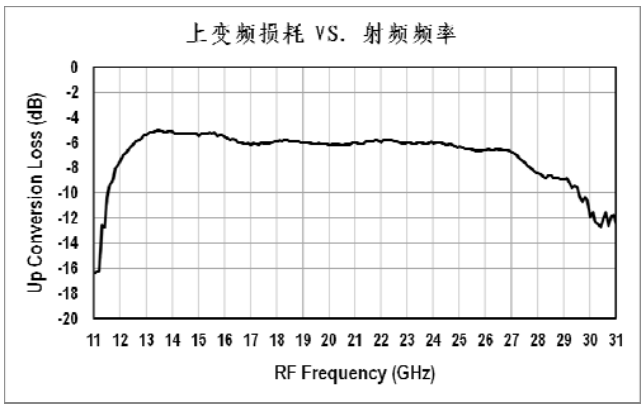
使用限制参数：

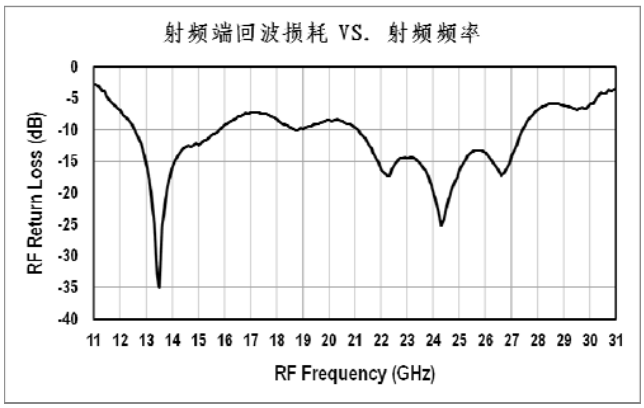
射频最大输入功率	24	dBm
本振最大输入功率	24	dBm
建议本振功率范围	+13～+20	dBm
存储温度	-65～+150	℃
使用温度	-55～+125	℃

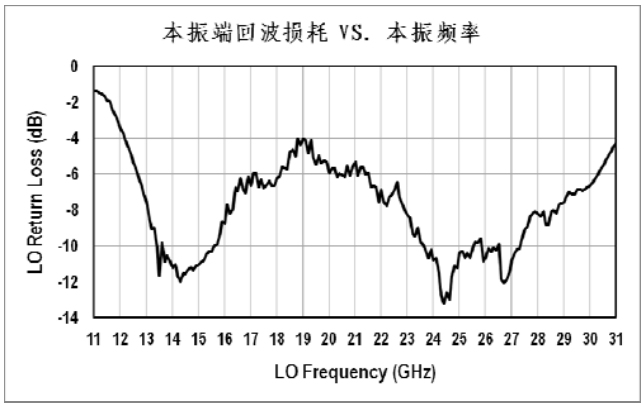
注：在建议本振功率范围内，混频器变频损耗随本振功率增加而减小，随本振功率减小而增加。

典型曲线：

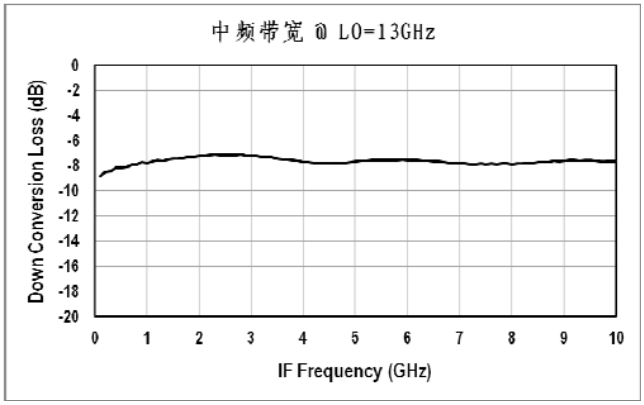


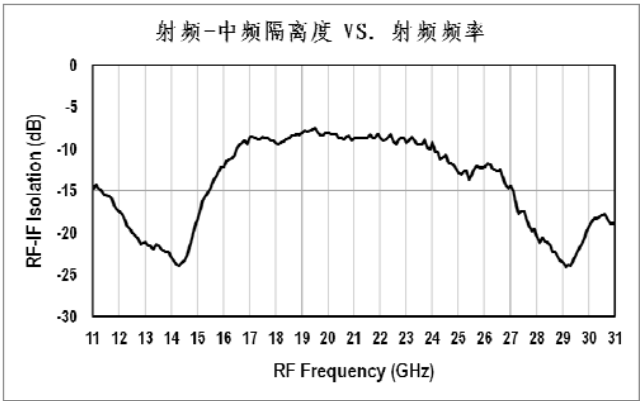


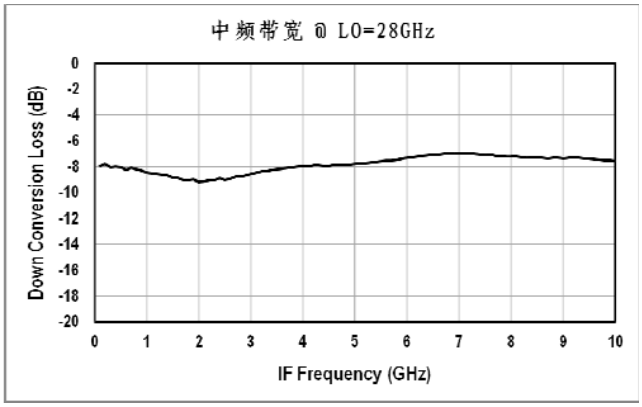


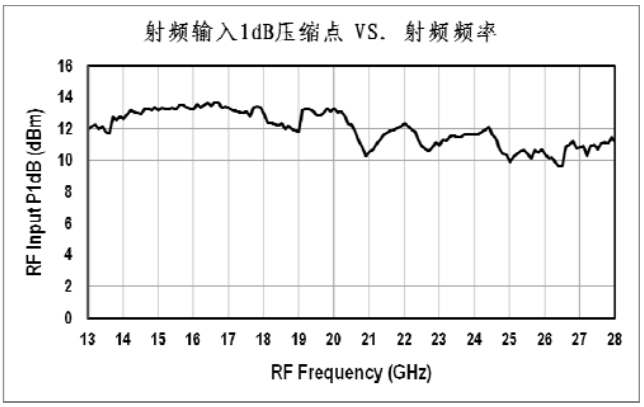


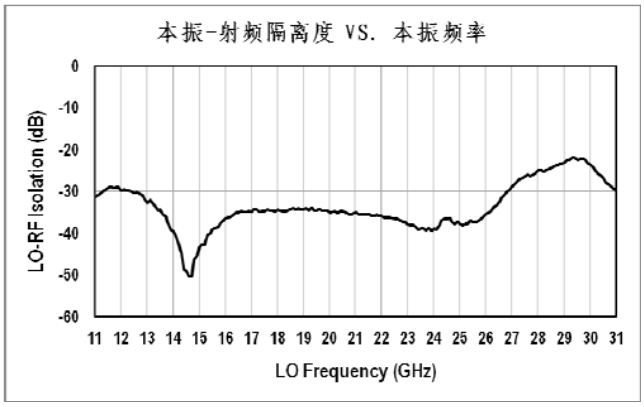
www.dianzibuy.com

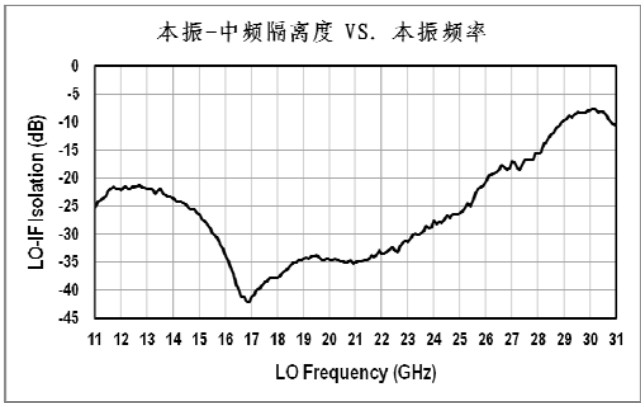






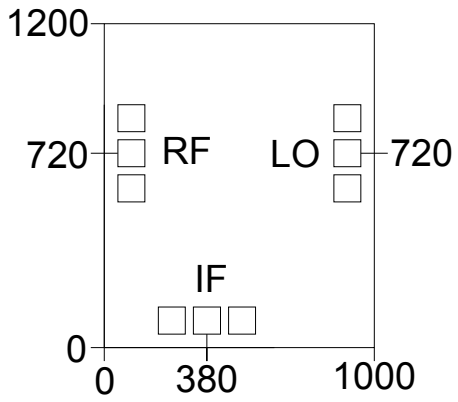




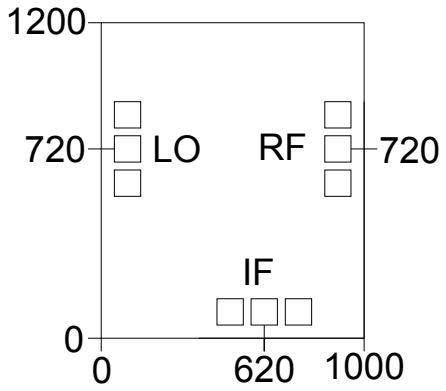


外形尺寸

NC1733C-1328 外形尺寸



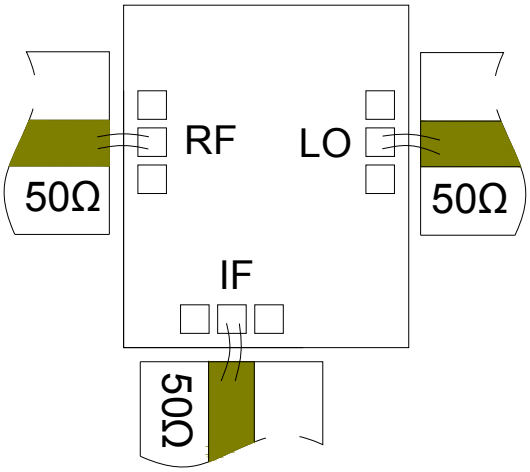
NC1733C-1328M 外形尺寸



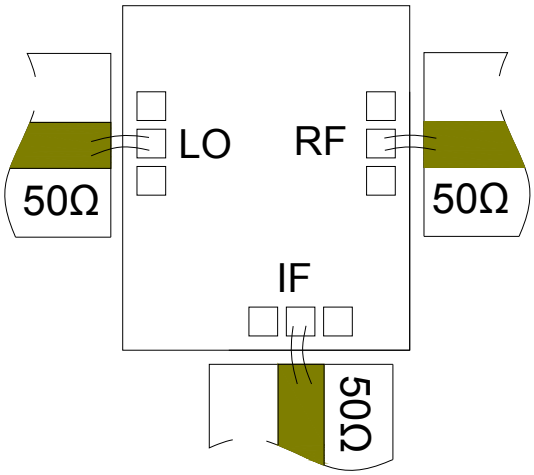
说明：所有尺寸单位为微米(μm)；
输入输出压点尺寸为 100×100μm^2；
外形尺寸公差±50μm。

建议装配图：

NC1733C-1328



NC1733C-1328M



注意事项：

1) 在净化环境装配使用。
2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心。
3) 键合线（直径 25μm 金丝）尽量短，不要长于 500μm。
4) 中频端无隔直电容，内部与二极管连接，射频、本振端无隔直电容，直流接地。
5) 用 80/20 金锡烧结，烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒。
6) 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
7) 干燥、氮气环境储存。
8) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。
9) 有问题请与供货商联系。

www.dianzibuy.com